

利用登録状況 (入退室システム登録者数 令和3年3月末時点)

教員(研究員を含む) と学生のみを抽出

学系	研究室名	教員	学生	総計	
電子システム	半導体工学	3	16	19	70
	電子デバイス工学	3	10	13	
	電子物性工学	1	15	16	
	光エレクトロニクス	2	16	18	
	光エンジニアリング	1		1	
	応用物質科学	3		3	
材料化学	高分子物理学	3	14	17	24
	高分子物性工学	1	2	3	
	高分子フォトンクス	1		1	
	応用高分子化学	1		1	
	アモルファス工学	1		1	
	機能高分子設計		1	1	
機械	輸送現象制御学	1	7	8	16
	機能表面加工学	1	1	2	
	先端材料学	1	5	6	
繊維	先端ファイブロ科学		1	1	1
	合計	23	88	111	

利用登録状況（機器利用登録者数 令和3年3月末時点）

		電子システム					材料化学				機械		合計	
		半 導 体 工 学	電 子 デ バ イ ス 工 学	電 子 物 性 工 学	光 エ レ ク ト ロ ニ ク ス	光 エ ン ジ ニ ア リ ン グ	応 用 物 質 科 学	高 分 子 物 理 学	高 分 子 物 性 工 学	高 分 子 フ ォ ト ニ ク ス	機 能 高 分 子 設 計	輸 送 現 象 制 御 学		先 端 材 料 学
フォトリソグラフィ装置	MIKASA アライナ	2	1											3
	両面マスクアライナ	1	5								8			14
	キャノン アライナ													0
	スプレーコーター													0
	有機ドラフト	3	9		2						8			22
成膜装置	RFスパッタ装置	1	1											2
	電子ビーム蒸着装置	2												2
	LL式電子ビーム蒸着装置													0
	実験用熱蒸着装置	2									1			3
	TEOS-CVD装置	2			1									3
ドライエッチング装置	Siディープエッチング装置		4			1	1							6
	化合物半導体エッチング装置	1	1		1									3
	簡易プラズマ処理装置	2						4		1	8			15
洗浄・ウエットエッチング装置	酸ドラフト	5	10		2						8			25
熱処理装置	熱処理炉													0
	急速アニール炉	4												4
	小型拡散炉	1												1
評価装置	電界放出型高分解能走査電子顕微鏡	11			6		1		2					20
	段差膜厚計	8	11	5	12		1	16		1	1	8		63
	レーザー顕微鏡	1			1							8		10
	卓上SEM (EDX)	12			5									17
分析装置	X線光電子分光装置	3	1	5			1					5	1	16
	高精度X線回析装置	15	3		3		1							22

研究室別利用時間と共用率(令和2年4月~令和3年3月)

	装置名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	合計	管理 使用 時間 研究室	共有 率
		光 エ ン ジ ニ ア リ ン グ	光 エ レ ク ト ロ ニ ク ス	電 子 デ バ イ ス 工 学	半 導 体 工 学	応 用 物 質 科 学	電 子 物 性 工 学	高 分 子 物 理 学	高 分 子 物 性 工 学	高 分 子 フ ォ ト ニ ク ス	輸 送 現 象 制 御 学	機 能 高 分 子 設 計	先 端 材 料 学	機 能 表 面 加 工 学			
1	MIKASA アライナ				13.5										13.5	0.0	100.0%
2	両面マスクアライナ										17.0				17.0	0.0	100.0%
3	キャノン アライナ														0.0	0.0	0.0%
4	スプレーコーター														0.0	0.0	0.0%
5	有機ドラフト		5.0	1.7	46.0						120.5				173.2	0.0	100.0%
6	RFスパッタ装置														0.0	0.0	0.0%
7	電子ビーム蒸着装置														0.0	0.0	0.0%
8	LL式電子ビーム蒸着装置				10.0										10.0	10.0	0.0%
9	実験用熱蒸着装置														0.0	0.0	0.0%
10	TEOS-CVD装置				9.0										9.0	0.0	100.0%
11	Siディープエッチング装置			14.3											14.3	14.3	0.0%
12	化合物半導体エッチング装置		15.0												15.0	0.0	100.0%
13	簡易プラズマ処理装置							79.0			49.7				128.7	0.0	100.0%
14	酸ドラフト		11.5	10.0	27.0						2.5				51.0	0.0	100.0%
15	熱処理炉														0.0	0.0	0.0%
16	急速アニール炉				7.5										7.5	7.5	0.0%
17	小型拡散炉														0.0	0.0	0.0%
18	電界放出型高分解能走査電子顕微鏡		82.5		306.9										389.4	0.0	100.0%
19	段差膜厚計		21.5	60.4	24.7		50.0	221.7			16.8				395.1	0.0	100.0%
20	レーザー顕微鏡										6.0				6.0	0.0	100.0%
21	卓上SEM (EDX)		20.0		182.2										202.2	0.0	100.0%
22	X線光電子分光装置			10.0	50.5		134.0						61.0	11.0	194.5	134.0	31.1%
23	高精度X線回析装置			84.0	1994.8										2078.8	84.0	96.0%
研究室別使用時間合計		0.0	155.5	180.333	2672.25	0	184	300.667	0	0	212.5	0.0	61.0	11.0	161.1	10.9	93.3%

共用前提装置

共用前提装置

共用前提装置

共用前提装置

共用前提装置

共用前提装置

共有率 93.3%

月別装置稼働時間 (令和2年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
MIKASA アライナ			7.0							3.0		3.5	13.5
両面マスクアライナ				0.5	1.5	1.0	3.0	2.0	6.0	1.5		1.5	17.0
キャノン アライナ													0.0
スプレーコーター													0.0
有機ドラフト			16.5	8.5	14.0	9.5	17.7	25.0	34.0	12.5	7.5	28.0	173.2
RFスパッタ装置													0.0
電子ビーム蒸着装置													0.0
LL式電子ビーム蒸着装置												10.0	10.0
実験用熱蒸着装置													0.0
TEOS-CVD装置			3.0							3.0		3.0	9.0
Siディープエッチング装置				3.4			4.0	4.1	2.8				14.3
化合物半導体エッチング装置								9.0	6.0				15.0
簡易プラズマ処理装置			7.5	9.0	14.3	18.0	8.5	15.0	36.5	15.5	0.5	4.0	128.7
酸ドラフト			2.0	3.5	4.0	9.0	5.5	2.0	11.0	6.0		8.0	51.0
熱処理炉													0.0
急速アニール炉			4.5								2.0		6.5
小型拡散炉													0.0
電界放出型高分解能走査電子顕微鏡	2.0		14.3	38.4	36.3	38.8	47.0	78.5	77.8	29.5	1.0	25.8	389.4
段差膜厚計	4.0	4.5	9.5	42.3	35.4	51.8	46.0	59.3	70.5	45.7	11.0	15.0	395.1
レーザー顕微鏡				1.0	1.0	1.5			1.0	1.3	0.3		6.0
卓上SEM (EDX)				14.3	21.0	39.0	30.5	28.3	14.8	32.5	16.0	6.0	202.2
X線光電子分光装置					3.5	3.5	25.5	61.0	70.5	50.5		52.0	266.5
高精度X線回析装置	19.0		116.7	258.3	128.5	213.6	217.0	268.8	301.0	221.8	160.0	174.2	2078.8
	25.0	4.5	181.0	379.3	259.5	385.7	404.7	552.8	631.7	422.7	198.2	331.1	3776.2